

Кремниевый фотодетекторный чип 1.6 мм — техническое описание

P/N : WS93-01C

Особенности

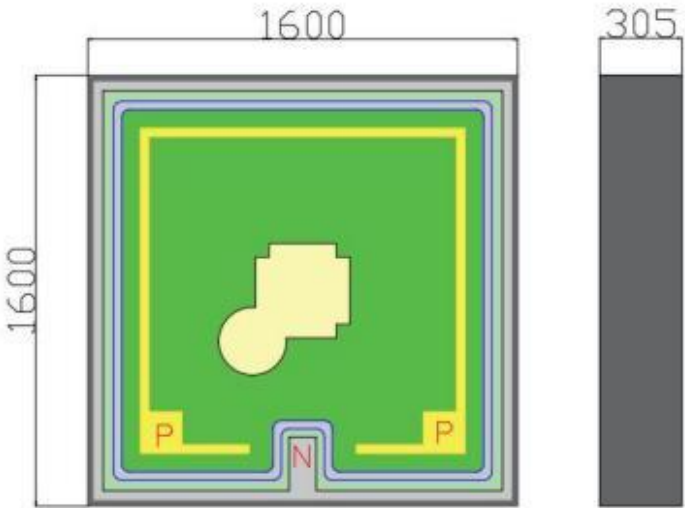
Si PIN фотодиодный чип

Структура

Планарная структура: PIN-диод; электроды: верхняя сторона (катод) — алюминий

(анод): алюминий

Задняя сторона покрыта SiO₂



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	1346±10 x 1346±10			мкм
Ширина чипа	1600			мкм
Длина чипа	1600			мкм
Высота чипа	290	305	320	мкм
Размер контактной площадки		153		мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	Vf	If=10mA, H=0	0.5		1.2	В
Обратное напряжение	Vbr	Ir=100μA, H=0	60			В
Обратный темновой ток	Id	Vr=10V			10	нА
Рабочий диапазон длин волн	λ		430		1100	нм
Обратный световой ток	IL	VR=5V, 1 mW/cm2 @940nm		10		мкА
Емкость	Cj	VR=3V, f=1MHz		10		пФ